

## 本期封面



2001年3期

栏目:

DOI:

论文题目: 蒸发淀积Al和Teflon AF薄膜间的相互作用

作者姓名: 丁士进 王鹏飞 张卫 王季陶 张台文 夏钟福

工作单位: 复旦大学电子工程系, 上海200433

通信作者: 王鹏飞

通信作者Email: [jtwang@fudan.ac.cn](mailto:jtwang@fudan.ac.cn)

文章摘要: 通过X-射线光电子光谱(XPS),研究了蒸发淀积Al与Teflon AF薄膜间的相互作用. 高分辨率Al2p, O1s, C1s和F1s XPS光谱分析表明在Al和Teflon AF界面处有Al的氟化物( $Al_xF_y$ )以及C-O-Al有机化合物的形成. 考虑到蒸发淀积Al前后, CF<sub>3</sub>基团降低和CF<sub>2</sub>基团增加, 可以认为 $Al_xF_y$ 中氟的来源主要是由于CF<sub>3</sub>基团中一个C-F键断裂而失去的氟原子, 同时产生的CF<sub>2</sub>游离基和其它游离基间结合, 导致界面处CF<sub>2</sub>基团增加.

关键词: Al, Teflon AF, 相互作用, X-射线光电子光谱

分类号: TG115.22

关闭